

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Yuuki TAUCHI, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

EXAMINER:

FILED: HEREWITH

FOR: AG BASE ALLOY THIN FILM AND SPUTTERING TARGET FOR FORMING AG BASE ALLOY THIN FILM

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §120**.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §119(e)**:

<u>Application No.</u>	<u>Date Filed</u>
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §119**, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

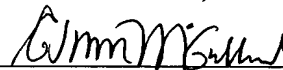
<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2002-231596	August 8, 2002
Japan	2002-233283	August 9, 2002
Japan	2002-239972	August 20, 2002
Japan	2002-361117	December 12, 2002
Japan	2003-003643	January 9, 2003
Japan	2003-004586	January 10, 2003
Japan	2003-122314	April 25, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s) _____
☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon

Registration No. 24,618

C. Irvin McClelland
Registration Number 21,124



22850

2759
US

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 8 日
Date of Application:

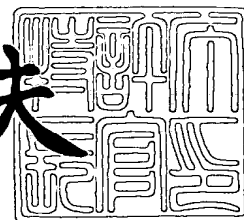
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 3 1 5 9 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 3 1 5 9 6]

出 願 人 株式会社神戸製鋼所
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 1 1 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 5 6 8 2 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 14PK5317

【提出日】 平成14年 8月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/1343

【発明の名称】 光反射膜およびこれを用いた液晶表示素子、ならびに光反射膜用スパッタリングターゲット

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所 神戸総合技術研究所内

【氏名】 中井 淳一

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号 株式会社神戸製鋼所 神戸総合技術研究所内

【氏名】 田内 裕基

【特許出願人】

【識別番号】 000001199

【氏名又は名称】 株式会社 神戸製鋼所

【代理人】

【識別番号】 100089196

【弁理士】

【氏名又は名称】 梶 良之

【電話番号】 06-6300-3590

【選任した代理人】

【識別番号】 100104226

【弁理士】

【氏名又は名称】 須原 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014731

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0103969

【包括委任状番号】 0000795

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光反射膜およびこれを用いた液晶表示素子、ならびに光反射膜用スパッタリングターゲット

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶表示素子の反射電極または反射板として用いられる光反射膜であって、B i および S b よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種の元素を合計量で 0.01～4 原子%含有する A g 基合金からなることを特徴とする光反射膜。

【請求項 2】 前記 A g 基合金が、さらに、希土類元素よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の元素を合計量で 0.01～2 原子%含有するものである請求項 1 に記載の光反射膜。

【請求項 3】 前記希土類元素が、N d および Y である請求項 2 に記載の光反射膜。

【請求項 4】 前記 A g 基合金が、さらに、A u、C u、P t、P d および R h よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の元素を合計量で 3 原子%以下（0 原子%を含まない）含有するものである請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の光反射膜。

【請求項 5】 請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の光反射膜を備えたことを特徴とする液晶表示素子。

【請求項 6】 請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の光反射膜を基板上に形成するために用いられるスパッタリングターゲットであって、この光反射膜の A g 基合金と同一の元素を同一の量含有する A g 基合金からなることを特徴とする光反射膜用スパッタリングターゲット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば反射型液晶表示素子等に使用され、背面において、室内光や自然光等を反射して光源とするための光反射膜に関する。

【0002】

【従来の技術】

液晶表示素子には反射型と透過型とがあるが、透過型液晶表示素子では光源としてランプを内蔵する必要があり、このランプの消費電力が大きい等の問題から、最近では、ランプを内蔵する必要がないため消費電力の少ない反射型液晶表示素子が注目されている。

【0003】

この反射型液晶表示素子には、TF T液晶パネルの液晶層背面に反射（金属）電極として、またはSTN液晶パネルの透明電極背面に反射板として光反射膜が必須的に設けられ、室内光や自然光等を反射して画面形成のための光源とされる。このため、光反射膜の反射率が高ければ高いほどより明るくて見やすい画面が形成される。

【0004】

従来は、この光反射膜として、反射率の高いAlの薄膜が用いられてきたが、最近ではより反射率が高く、化学的な腐食にも強いAg主体の薄膜（Ag薄膜）が光反射膜として用いられるようになってきた。

【0005】

しかし、Ag薄膜は、液晶表示素子の製造の際に高温下で長時間空気中に曝された場合や、製造後の使用の際において高温高湿下で長時間曝された場合等に結晶粒の粗大化、Ag原子の凝集、Agの酸化等に起因する白濁や白点が発生し、反射率が低下してしまうことからAg本来の高い反射率が得られないという問題があった。さらには、素子製造中の不可避免的な熱履歴（～200℃）により、結晶粒の成長やAg原子の凝集に伴う薄膜表面の粗度の増大や異常粒成長により素子形成が困難にならないしは反射率が一層低下するなどの問題があった。

【0006】

そこで、Agの結晶粒の成長やAg原子の凝集を防止してAg本来の高い光反射率を発揮させ維持する目的でAgに異種元素を添加する提案がなされている。

【0007】

例えば、特開平7-134300号公報には、銀より酸化されやすい金属、具体的にはマグネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウムおよびハフニウム

よりなる群から選択された1種または2種以上の金属を含有する銀合金（A g 基合金）からなる薄膜が開示されている。

【0008】

また、特開平9-230806号公報には、銀元素のマイグレーションを防止する異種元素、具体的にはアルミニウム、銅、ニッケル、カドミウム、金、亜鉛、マグネシウムからなる群から選択された1種または2種以上の金属との合金である銀系金属材料（A g 基合金）からなる薄膜が開示されている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の先行技術によっても、A g の結晶粒の成長やA g 原子の凝集を十分に阻止しえず、A g 本来の高い光反射率を確保することができなかった。

【0010】

そこで、本発明の目的は、A g の結晶粒の成長やA g 原子の凝集を可及的に防止できるA g 基合金を見出すことにより、A g 本来の高い光反射率とほぼ同等の高い光反射率を備えた高性能の光反射膜やこの光反射膜を用いた液晶表示素子を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、液晶表示素子の反射電極または反射板として用いられる光反射膜であって、B i およびS b よりなる群から選ばれた1種または2種の元素を合計量で0.01～4原子%含有するA g 基合金からなることを特徴とする光反射膜である。

【0012】

請求項2の発明は、前記A g 基合金が、さらに、希土類元素よりなる群から選ばれた1種または2種以上の元素を合計量で0.01～2原子%含有するものである請求項1に記載の光反射膜である。

【0013】

請求項3の発明は、前記希土類元素が、N d およびYである請求項2に記載の

光反射膜である。

【0014】

請求項4の発明は、前記Ag基合金が、さらに、Au、Cu、Pt、PdおよびRhよりなる群から選ばれた1種または2種以上の元素を合計量で3原子%以下（0原子%を含まない）含有するものである請求項1～3のいずれか1項に記載の光反射膜である。

【0015】

請求項5の発明は、請求項1～4のいずれか1項に記載の光反射膜を備えたことを特徴とする液晶表示素子である。

【0016】

請求項6の発明は、請求項1～4のいずれか1項に記載の光反射膜を基板上に形成するために用いられるスパッタリングターゲットであって、この光反射膜のAg基合金と同一の元素を同一の量含有するAg基合金からなることを特徴とする光反射膜用スパッタリングターゲットである。

【0017】

【発明の実施の形態】

本発明者らは、液晶表示素子の製造の際に光反射膜が空気中に曝された場合や製造後の使用の際において高温高湿下で長時間曝された場合に起きる現象を促進的に把握するために、温度80℃、相対湿度90%という高温高湿下で、Ag単独の光反射膜（膜厚100nm）を48時間放置する環境試験を実施した。この光反射膜の反射率は、環境試験前の反射率（波長650nm）に比べると、環境試験後には7.0%程度低下してしまうことがわかった。この反射率の低下（以下、「反射率の経時低下」という。）の原因は、上記従来技術の説明で述べたように、結晶粒の成長やAg原子の凝集等の要因によるものと考えられる。

【0018】

そこで、本発明者らは、この反射率の経時低下を防止してAg本来の高反射率を得るには、これらの要因を除去ないしは抑制する合金成分を見出すことが重要との考えに基づいて鋭意研究を行った。

【0019】

研究の結果、本発明者らは、A g に、B i および／または S b (B i および S b よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種の元素) を含有させることによって、A g 本来の高反射率を維持しながら、A g の凝集や結晶粒成長を抑制し、反射率の経時低下を抑制できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0020】

従来から、光反射膜として純 A g だけではなく A g 基合金を使用する検討が行われているが、本発明で規定するように、A g に B i や S b を添加し、A g 原子の凝集や A g の結晶粒の成長を抑制しようとする知見は従来技術には認められない。A g 原子の凝集や A g の結晶粒成長の抑制については、本発明者らの、希土類元素を添加した A g 基合金からなる光反射膜の発明 (特願 2002-01729) があるが、本発明における B i、S b を含有する A g 基合金からなる光反射膜は、それ以上の反射率と耐久性を有するものである。

【0021】

本発明では、B i および／または S b を含む A g 基合金を光反射膜として用いることで、反射率の経時低下を抑制して高い光反射率を維持するものであるため、従来技術とは明確に区別される技術思想に基づくものである。なお、後述するように、B i および／または S b を含む A g 基合金に、コストが低い希土類元素、例えば N d や Y を添加した合金を用いることもできる。さらに、耐酸化性を向上させる成分である A u、C u、P t、P d、R h を含む三元系または四元系以上の合金を用いることもできる。以下、本発明を詳細に説明する。

【0022】

本発明では、例えば反射型液晶表示素子等に用いられる光反射膜においては可視光の反射特性が要求される点を考慮して、反射率を波長 650 nm で測定して反射特性を検討した。なお、以下の説明において「初期反射率 (%)」は、光反射膜を形成した直後の反射率 (%) を意味し、この値の大小は、合金元素の種類と量によって左右される。また、「反射率の経時変化量 (%)」は、「環境試験後の反射率 (%) - 初期反射率 (%)」で定義され、この経時変化量 (%) がマイナスの場合には、環境試験後の反射率が初期反射率より低下することを意味するものである。

【0023】

光反射膜がBiおよび／またはSbを含有するAg基合金で形成されると、Agの結晶粒の成長やAg原子の凝集が抑制される。特にスパッタリング法で形成された薄膜は、原子空孔等の多くの欠陥を含むため、Ag原子が移動・拡散し易く、その結果、Ag原子が凝集するものと考えられるが、Bi、SbがAgの結晶中に存在することによりAg原子の移動・拡散が抑制され、Agの結晶粒成長やAg原子の凝集を抑制するものと考えられる。

【0024】

Biおよび／またはSbを合計量で0.01原子%以上添加することにより、Agの結晶粒の成長やAg原子の凝集を抑制する効果が発現する。ただし、これらの元素の添加量の増大とともに初期反射率の低下や電気抵抗率の増大を招くため、Biおよび／またはSbの合計添加量は4原子%以下とすることが好ましい。特に液晶表示素子が反射体と電極の両方の役割を担う場合には、電気抵抗率はできるだけ低くすることが望ましい。すなわち、初期反射率に関しては、Biおよび／またはSbの合計添加量は2原子%以内にすれば、80%以上の高い初期反射率を維持できる。一方、電気抵抗率に関しては、通常、液晶表示素子の配線膜に用いられるAl合金（Al-Ta、Al-Ndなど）の電気抵抗率が5～15 $\mu\Omega\text{cm}$ 程度であることから、後述の実施例で示すように、Bi、Sbとも1.8原子%以内にすれば、Al合金配線と同等の15 $\mu\Omega\text{cm}$ 以下の電気抵抗率が得られる。ただし、Al合金と同様に液晶表示素子配線膜に用いられるCrやMoなどの高融点金属材料では、電気抵抗率は～200 $\mu\Omega\text{cm}$ 程度で使用されていることから、Bi、Sbの添加量が1.8原子%を超えた場合でも、問題なく使用可能である。したがって、Biおよび／またはSbの合計量のより好ましい上限は2原子%である。

【0025】

一方、Agの結晶粒成長やAg原子の凝集が起こり易い環境を促進的に再現するための環境試験として、光反射膜を温度80℃、相対湿度90%の高温高湿環境下に48時間放置した場合でも、Biおよび／またはSbが合計量で0.05原子%以上存在すれば、環境試験前の反射率〔＝初期反射率〕（%）と環境試験

後の反射率 (%) との差を 1 % 以下に抑えられることから、B i または / および S b の合計量のより好ましい下限は 0.05 原子% である。

【0026】

本発明の光反射膜形成に用いられる A g 基合金には、さらに、希土類元素、特に N d および / または Y が含まれていてもよい。上記の B i や S b に比べ効果が小さいものの、N d や Y にも A g の耐凝集性を向上する効果があり、かつ N d や Y は B i や S b に比べ材料コストが低いため、B i や S b の一部と置換すればコストを低減することが可能となるからである。なお、N d および / または Y の合計添加量は 0.01 原子% 以上とすることが好ましい。ただし、N d や Y の添加は初期反射率や電気抵抗率の低下を招くことから、その合計量は好ましくは 2 原子% 以下、より好ましくは 1 原子% 以下とする。(なお、A g に B i および / または S b を添加せずに、N d および / または Y のみを添加しても、A g の耐凝集性を向上できるが、後記実施例で述べるように耐 N a C l 性が向上しない課題がある。)

【0027】

また、A u、C u、P t、P d、R h などを耐酸化性の向上を目的として添加してもよい。これらの元素は、A g の凝集を抑制する効果はないが、化学的安定性を増加させる効果があり、反射率の経時低下を抑制する作用を有する。なお、これらの元素は、添加量の増大とともに、特に短波長領域 (400 nm 前後) の反射率の低下を招くことから、合計量は好ましくは 3 原子% 以下、より好ましくは 2 原子% 以下とする。

【0028】

本発明の光反射膜は、B i および / または S b を含有し、必要に応じて N d、Y、もしくは C u、A u、P d、R h、P t を含有し、残部は実質的に A g であることが、高い初期反射率を得るために好ましい実施形態であるが、本発明の作用を損なわない範囲であれば、上記成分以外の他の成分を添加してもよい。例えば、Z n、T i、M g、N i 等を化学的腐食や反応防止の観点から添加してもよい。また、A r、O₂、N₂等のガス成分や、溶解原料である A g 基合金に含まれている不純物も許容される。

【0029】

本発明の光反射膜は、高い反射率を長時間維持できるため、反射型液晶表示素子に用いるのが好適である。また、本発明の光反射膜は、加熱時の結晶粒成長等の構造変化に対する耐性に優れていることから、製造工程中に通常200～300℃の加熱工程を経る液晶表示素子に特に適している。さらに、この光反射膜は導電性を有しているので、反射型液晶表示素子の反射電極として利用することができる。また、透明電極の背面に反射板として設けてもよい。反射電極として利用する場合の電極基板としては、ガラス基板、プラスチックフィルム基板等、公知のものが利用可能である。反射板の基材も同様ものが利用可能である。さらに、光反射膜と配線膜を兼ねるように用いることもできる。

【0030】

光反射膜を上記基板または基材上に形成するには、スパッタリング法を用いることが好ましい。BiやSbは、化学平衡の状態ではAgに対する固溶限が極めて小さいが、スパッタリング法により形成された薄膜では、スパッタリング法固有の気相急冷によって非平衡固溶が可能になるため、その他の薄膜形成法でAg基合金薄膜を形成した場合に比べ、上記合金元素がAgマトリックス中に均一に存在しやすい。その結果、Ag基合金の耐酸化性が向上し、かつAg原子の凝集に対する抑制効果が発揮される。

【0031】

光反射膜の膜厚は50～300nmが好ましい。50nmより薄い膜では、光が透過し始めるため、反射率が低くなる。一方、300nmを超えると、反射率に関しては問題ないが、生産性やコスト面で不利となる。

【0032】

スパッタリングの際には、スパッタリングターゲット（以下、単に「ターゲット」ともいう。）として、これまで説明した光反射膜と同一の組成のAg基合金を用いることにより、所望の化学組成の光反射膜を得ることができる。ターゲットとしては、溶解・鋳造法で作製したAg基合金（溶製Ag基合金）を使用することが好ましい。溶製Ag基合金は組織的に均一であり、スパッタ率や出射角度を一定にすることができるので、成分組成が均一な光反射膜を得ることができる。

。上記溶製 Ag 基合金ターゲットの酸素含有量を 100 ppm 以下に制御すれば、膜形成速度を一定に保持し易くなり、光反射膜中の酸素量も低くなるため、反射率や電気抵抗率が向上する。

【0033】

本発明の反射型液晶表示素子は、本発明の光反射膜を備えていればよく、その他の液晶表示素子としての構成は特に限定されず、液晶表示素子の分野において公知のあらゆる構成を採用することができる。

【0034】

【実施例】

以下実施例によって本発明をさらに詳述するが、下記実施例は本発明を制限するものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更実施することは、全て本発明に含まれる。

【0035】

（実施例 1）

純 Ag ターゲット上に 5 mm × 5 mm の Bi または Sb 金属チップを配置し、DC マグネトロンスパッタリングにより、ガラス基板上に厚さ 100 nm の表 1 の試験 No. 1 ~ 12 に示す成分組成の試料を作成した。薄膜の組成については、別途、同一条件で膜厚 1 μm の試料を作製し、ICP-発光分光分析法をもちいて組成の同定を行った。ターゲットサイズは φ 100 mm で、ガラス基板のサイズは φ 50 mm である。主な成膜条件は、到達真空度： 6.67×10^{-4} Pa、成膜時の Ar ガス圧：0.267 Pa、基板温度：25℃、ターゲット-基板間距離：55 mm である。

【0036】

成膜後直ちに、各試料の反射率を可視紫外分光光度計（島津製作所製）で測定した。また、これらの試料の環境試験（温度 80℃、相対湿度 90%、時間 48 h）後の反射率を上記分光光度計で測定し、環境試験前後の反射率の変化量を評価した。さらに環境試験前後の表面粗度を原子間力顕微鏡（AFM）で測定し、環境試験前後の表面粗度の変化量を評価した。さらに塩水浸漬試験（NaCl：0.05 mol/L、15 min）を行い、目視で光反射膜の変色の程度および

基板からの光反射膜の剥離の有無を観察し、耐NaCl性を評価した。

【0037】

(比較例1)

純Agターゲット上に配置する金属チップを、上記実施例1のSiまたはSbに代えて、Nd、In、NbまたはSnとし、上記実施例1と同じ成膜条件で表1の試験No. 13～16に示す組成のAg合金薄膜を作製し、実施例1と同様の評価を行った。

【0038】

実施例1および比較例1についての評価結果を表1に併せて示す。表1の実施例1に示すように、純Ag薄膜(試験No. 1)に比べ、BiまたはSbの添加(試験No. 2～12)により、環境試験前後の反射率の変化量および表面粗度の変化量が顕著に抑制されているのが分かる。BiまたはSbの添加量については、0.01原子%でも効果が認められるが(試験No. 2、8)、特に0.05原子%以上で効果が大きい(試験No. 3～7、9～12)。また塩水浸漬試験後においても、BiまたはSbの添加により、光反射膜の黄色化などの変色や基板からの光反射膜の剥離がなくなり、良好な耐久性を示すことが分かる。

【0039】

これに対し、表1の比較例1に示すように、Ag-Ndは、環境試験前後の反射率の変化量の抑制に対しては良好な結果を示すが、NaCl耐性がない(試験No. 13)。またAg-In、Ag-Nb、Ag-Snでは表面粗度の変化量に対する抑制効果が非常に低い(試験No. 14～16)。

【0040】

(実施例2)

Ag-0.2%BiまたはAg-0.2%Sbのターゲット上に、5mm×5mmのCu、AuまたはYの金属チップを設置した複合ターゲットを用いて、実施例1と同様の成膜条件で試料を作製した。これらの試料について実施例1と同様の評価を行った結果を表2に示す。なお表2には、比較のため表1中の試験No. 1および4を再掲した。

【0041】

A g - B i にさらに N d または Y を添加することにより、表面粗度およびその変化量がさらに改善されることが分かる（試験 N o . 1 7、1 8）。また、A g - B i または A g - S b にさらに C u または A u を添加した場合には、表面粗度のさらなる改善効果はないものの、反射率の変化量を低減する効果があることが分かる（試験 N o . 1 9 ~ 2 4）。

【 0 0 4 2 】

【表1】

評価結果											
試験 No.	組成	添加 元素量 (原子%)	反射率 (%) ; 波長 400nm			表面粗度 (nm)			電気抵抗率 ($\mu \Omega$ cm)	塩水浸漬試験	
			初期反射率 環境試験前 [A]	環境試験 後 [B]	変化量 [B-A]	環境試験 前 [C]	環境試験 後 [D]	変化量 [D-C]		変色 (黄色化)	剥離
1	純 Ag	-	90.8	63.5	-27.3	4.2	7.3	3.1	2.3	×	有り
2	Ag-Bi	0.01	89.4	83.0	-5.4	2.1	2.8	0.7	2.5	△	なし
3		0.04	88.2	87.2	-1.0	0.92	1.01	0.09	2.6	○	なし
4		0.19	86.2	85.4	-0.8	0.65	0.71	0.06	3.3	○	なし
5		0.9	81.2	81.4	+0.2	0.64	0.65	0.01	7.0	○	なし
6		2.0	74.3	73.8	-0.5	0.63	0.62	-0.01	14.8	○	なし
7	Ag-Sb	3.1	62.3	62.4	+0.1	0.64	0.66	0.02	20.6	○	なし
8		0.009	89.4	83.0	-5.4	2.1	2.8	0.7	2.4	△	なし
9		0.05	88.2	87.2	-1.0	0.92	1.01	0.09	2.5	○	なし
10		0.21	86.2	85.4	-0.8	0.65	0.71	0.06	3.2	○	なし
11		1.8	74.3	73.8	-0.5	0.63	0.62	-0.01	13.6	○	なし
12	比較例 1	3.0	62.3	62.4	+0.1	0.64	0.66	0.02	19.5	○	なし
13		0.4	86.9	85.0	-1.9	0.52	0.61	0.09	4.9	×	有り
14		0.40	87.8	83.3	-4.5	3.6	7.1	3.5	4.5	△	なし
15		0.92	83.8	81.3	-2.5	2.1	3.1	1.0	9.5	△	有り
16	Ag-Sn	0.88	85.7	79.0	-6.7	3.5	6.2	2.7	6.4	×	有り

注) 変色(黄色化): ○:変色なし、△:少し黄色化、×:かなり黄色化

【0043】

【表 2】

	試験 No.	組成	添加元素量 (原子%)		評価結果						電気抵抗率 ($\mu\Omega\text{cm}$)	
					反射率 (%) : 波長 400nm			表面粗度 (nm)				
					初期反射率 環境試験前 [A]	環境試験 後 [B]	変化量 [B-A]	環境試験 前 [C]	環境試験 後 [D]	変化量 [D-C]		
	1	純 Ag	-	-	90.8	63.5	-27.3	4.2	7.3	3.1	2.3	
	4	Ag-Bi	0.19	-	86.2	85.4	-0.8	0.65	0.71	0.06	3.3	
	17	Ag-Bi-Nd	0.19	0.7	85.1	84.7	-0.4	0.48	0.49	0.01	測定せず	
	18	Ag-Bi-Y	0.19	0.5	85.4	84.8	-0.6	0.59	0.56	-0.03	測定せず	
	19	Ag-Bi-Cu	0.19	0.9	86.0	85.5	-0.5	0.68	0.70	0.02	3.4	
	20	Ag-Bi-Au	0.19	1.0	85.9	85.7	-0.2	0.70	0.71	0.01	3.5	
	21	Ag-Bi-Cu	0.19	3.0	87.5	87.2	-0.3	0.63	0.72	0.09	4.1	
	22	Ag-Sb-Au	0.20	1.0	86.1	86.0	-0.1	0.65	0.68	0.03	3.2	
	23	Ag-Sb-Cu	0.20	1.0	85.8	85.8	0.0	0.64	0.70	0.06	3.4	
	24	Ag-Sb-Cu	0.20	3.0	85.1	85.1	0.0	0.59	0.62	0.03	3.8	
実 施 例 2												

実施例 2

【 0 0 4 4 】

【発明の効果】

以上述べたように、本発明によれば、A g 本来の高い光反射率とほぼ同等の高い光反射率を備えた高性能の光反射膜、この光反射膜を用いた液晶表示素子、およびこの光反射膜形成用のスパッタリングターゲットを提供できるようになった。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液晶表示素子の反射電極または反射板として用いられる光反射膜であって、A g の結晶粒の成長や凝集を可及的に防止できる A g 基合金を見出すことにより、A g 本来の高い光反射率とほぼ同等の高い光反射率を備えた高性能の光反射膜を提供する。

【解決手段】 B i および S b よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種の元素を合計量で 0. 0 1 ~ 4 原子%含有し、必要に応じて、さらに N d および Y よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種の元素を合計量で 0. 0 1 ~ 2 原子%、もしくは A u、C u、P t、P d および R h よりなる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の元素を合計量で 3 原子%以下含有する A g 基合金からなる光反射膜。

【選択図】 なし

特願 2002-231596

出願人履歴情報

識別番号 [000001199]

1. 変更年月日 2002年 3月 6日
[変更理由] 住所変更
住 所 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号
氏 名 株式会社神戸製鋼所
2. 変更年月日 2003年 4月 22日
[変更理由] 名称変更
住所変更
住 所 兵庫県神戸市中央区脇浜町二丁目10番26号
氏 名 株式会社神戸製鋼所